(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-73003

(43)公開日 平成6年(1994)3月15日

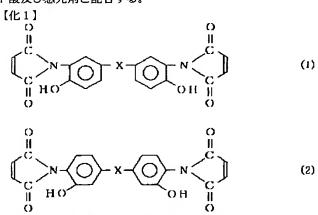
(51)Int.Cl. ⁵ C 0 7 D 207/452 C 0 8 K 5/28 5/3415 C 0 8 L 79/08 G 0 3 F 7/008	識別記号 5 LRB	庁内整理番号 8314-4C 7242-4 J 7242-4 J 9285-4 J	FI	技術表示箇所
			審査請求 未	・請求 請求項の数 2(全 17 頁) 最終頁に続く
(21)出顧番号	特顧平4-229791		(71)出夏	頭人 000003078 株式会社東芝
(22)出顧日	平成4年(1992)8	月28日	(72)発明	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 明者 大場 正幸 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝総合研究所内
			(72)発明	明者 真竹 茂 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝総合研究所内
			(74)代理	型人 弁理士 則近 憲佑

(54)【発明の名称】 ピスマレイミド化合物及び感光性樹脂組成物

(57)【要約】

きる。

【構成】 下記一般式(1)及び(2)のいずれかにて示されるピスマレイミド化合物をポリイミド、ポリアミド酸及び感光剤と配合する。



(式中、Xは単結合又は2価の有機基を表す。)

【効果】 基体との密着性に優れたポリイミド膜パターンを、アルカリ現像による簡単なプロセスで解像度高く形成することが可能な感光性樹脂組成物を得ることがで

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)及び(2)のいずれかにて示されることを特徴とするピスマレイミド化合物。

$$\begin{array}{c|c}
(\text{K}1) & & & & & & \\
0 & & & & & \\
\hline
C & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
& & & & & \\
C & & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
& & & & \\
C & & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
& & & & \\
C & & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
& & & & \\
C & & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
& & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
& & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & & & & & & & & & & & & & & & \\
C & & & & & & & & & & & & & & & \\
C & & & & & & & & & & & & & \\
C & & & & & & & & & & & & \\
C & & & & & & & & & & & \\
C & & & & & & & & & & \\
C & & & & & & & & & & \\
C & & & & & & & & & & \\
C & & & & & & & & & \\
C & & & & & & & & & \\
C & & & & & & & & & \\
C & & & & & & & & \\
C & & & & & & & & \\
C & & & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & & & & & \\
C & & & \\$$

(式中、R₁ , R₃ は4価の有機基、R₂ , R₄ は2価の有機基を表す。)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規なビスマレイミド 化合物及びこれを用いた感光性樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体装置において、デバイスを外部環境の影響から保護しその信頼性を高める目的で、デバイス表面に保護膜(パッシベーション膜)を設ける処理がなされている。一般的に、前記保護膜の材料としては絶縁性等の電気特性、及び耐熱性に優れたポリイミド樹脂が広く用いられている。また、半導体装置の多層配線構造における層間絶縁膜としても、ポリイミド樹脂が広く使用されている。

【0003】上記のようなポリイミド樹脂によるパッシベーション膜又は層間絶縁膜の形成は、例えば以下に示す手順によって行なわれる。すなわち該ポリイミド樹脂の前駆体であるポリアミド酸のワニスを、所定の半導体デバイス表面上に塗布する。これを加熱処理することにより、前記ポリアミド酸の環化反応に伴なう熱硬化が生じ、ポリイミド膜が成膜される。次いでポリイミド膜表

(式中、Xは単結合又は2価の有機基を表す。)

【請求項2】 下記一般式(3)で示される反復単位を 有するポリイミド並びに下記一般式(4)で示される反 復単位を有するポリアミド酸及びその誘導体の少なくと も1種と、

請求項1記載のピスマレイミド化合物と、

感光剤とを含有することを特徴とする感光性樹脂組成物。

(3)

【化2】

複雑化が問題となる。

【0004】さらに近年、フォトレジストとしての感光性を備えたポリイミドを用いて前述したような工程を簡略化することが試みられている。例えば特公昭59-52822号には、ポリアミド酸と感光性成分としてのアクリロイル基を有する化合物と共重合モノマとしてのマレイミド化合物と増感剤等とが配合されてなる感光材料が開示されている。しかしながら、このような感光性ポリイミドではパターン形成の際の現像液として有機溶剤が用いられるため、現像時にパターンが膨潤して解像度を高めることが困難であるという問題があった。またこのような問題に鑑み、特開昭64-60630号にはフェノール性水酸基を有するポリイミド及び感光剤からなるアルカリ現像の可能な感光性ポリイミドが示されているが、この感光性ポリイミドにおいては、パターン形成後のポリイミド膜

と基体との充分な密着性が得られていない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、アルカリ現像によるポリイミド膜パターンの形成が可能な感光性ポリイミドが現在要望されているが、このような感光性ポリイミドではこれまで、得られるポリイミド膜と基体との密着性が不充分である等の不具合があった。

【0006】本発明はこのような問題を解決してアルカリ可溶性を有し、例えば感光性ポリイミド中に配合したときアルカリ現像によるポリイミド膜パターンの形成を可能にするとともに、基体との密着性を高めることのできるビスマレイミド化合物及びこれを用いた感光性樹脂組成物を提供することを目的としている。

[0007]

【課題を解決するための手段及び作用】本発明は、下記一般式(1)及び(2)のいずれかにて示されるビスマレイミド化合物であり、さらには下記一般式(3)で示される反復単位を有するポリイミド並びに下記一般式

(4) で示される反復単位を有するポリアミド酸及びそ

の誘導体の少なくとも1種と前記ピスマレイミド化合物 と感光剤とを含有する感光性樹脂組成物である。

[0008]

$$\begin{bmatrix}
(4C3) \\
C \\
C \\
N
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
C \\
C \\
N
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
C \\
C \\
C
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c|c}
O & O & O \\
O & O & O \\
O & O & O \\
O & O & O
\end{array}$$
(2)

(式中、Xは単結合又は2価の有機基を表す。)

[0009]

【化4】

$$\begin{array}{c|c}
 & O & O \\
 & \parallel & \parallel \\
 & C & R_1 & C \\
 & \parallel & \parallel \\
 & O & O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & N - R_R
\end{array}$$
(3)

$$\begin{array}{c|c}
O & O \\
\parallel & \parallel \\
H & C \\
\hline
N & R_4
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
H & C \\
H & O & C \\
\hline
H & O & C \\
\hline
H & O & C \\
\hline
H & O & C \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
O & O \\
N & R_4
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
A & C & O & H \\
\hline
H & O & C \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
A & C & O & H \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
A & C & O & H \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
A & C & O & O & H \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
A & C & O & O & H \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
A & C & O & O & H \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
A & C & O & O & H \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
A & C & O & O & H \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
A & C & O & O & H \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
A & C & O & O & H \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
A & C & O & O & H \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
A & C & O & O & H \\
\hline
\end{array}$$

(式中、 R_1 , R_3 は 4 価の有機基、 R_2 , R_4 は 2 価の有機基を表す。)

【0010】本発明のビスマレイミド化合物は、芳香環に直接結合した水酸基、すなわちフェノ―ル性水酸基を有する点で特徴的である。以下、まずこの本発明のビスマレイミド化合物について説明する。

【0011】本発明のビスマレイミド化合物は、適当な有機溶剤中0~50℃の条件で、下記一般式(5)又は

(6)で示されるジアミノ化合物1モルに対し 2.0~3.0モル程度の無水マレイン酸を反応せしめ、下記一般式(7)又は(8)で示されるビスマレアミド酸を得た後、得られたビスマレアミド酸を脱水環化させてイミド化することにより合成することができる。このとき前記

有機溶剤としては、通常アセトン、メチルエチルケトン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、N, N-ジメチルホルムアミド、<math>N, N-ジメチルアセトアミド、<math>N-メチルー2ーピロリドン等が用いられる。さらに上記ジアミノ化合物としては、具体的には3, $3^{\prime}-$ ジアミノー4, $4^{\prime}-$ ジヒドロキシビフェニル、4, $4^{\prime}-$ ジアミノス(3-アミノー4-ヒドロキシビフェニル)へキサフロロプロパン、2, 2-ビス(4-アミノ-3-ヒドロキシフェニル)へキサフロロプロパン、2, 2-ビス(4-アミノ-3-ヒドロキシフェニル)へキサフロロプロパン等が挙げられる。

[0012]

【化5】

$$\begin{array}{c|c}
H_Z N & & & & N \\
H O & & & & \\
\end{array}$$
(5)

$$\begin{pmatrix}
0 & H & O \\
H & N & - C \\
H & O & H & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & H & H \\
0 & H & - C \\
0 & H & 0 & C
\end{pmatrix}$$
(7)

$$\begin{pmatrix}
0 & H & O \\
C & -N & O \\
HOOC
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & H & \parallel \\
0 & H & 0
\end{pmatrix}$$

(式中、Xは単結合又は2価の有機基を表す。)

【0013】またここで、前記ピスマレアミド酸を脱水環化させるためには、脱水剤として無水酢酸を用いることが好ましい。具体的には、上記ジアミノ化合物の使用量1モル当り無水酢酸を2~10モル、さらに触媒として酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、酢酸マンガン、酢酸マグネシウム、酢酸コバルト等の金属化合物を0.01~0.5モルとトリエチルアミン、ピリジン、塩化コリン等の第三級アミンを0.01~1.0℃の

条件で反応させる。ただしこの反応の際には、ビスマレイミド酸が脱水環化によりイミド化すると同時にビスマレアミド酸中の水酸基がアセチル化され、下記一般式

(9) 又は(10) で示されるジヒドロキシビスマレイミドジエステルが生成する。従って、引き続いて前記ジヒドロキシビスマレイミドジエステルのアセチル基を加水分解して、目的のビスマレイミド化合物を得る。

[0014]

【化6】

$$\begin{array}{c|c}
 & O \\
 & O \\$$

(式中、Xは単結合又は2価の有機基を表す。)

【0015】すなわち、例えば前記ジヒドロキシビスマレイミドジエステルを反応系より分離取得して乾燥した後に、これをイオウ又はリンのオキシ酸に溶解させる。このイオウ又はリンのオキシ酸としては、硫酸、チオ硫酸、亜硫酸、正リン酸、正亜リン酸、ピロリン酸、ポリリン酸等が挙げられ、これらは1種又は2種以上を混合して用いることができる。さらにこのとき、ジヒドロキ

シビスマレイミドジエステルの溶解度を高めるために、 前述したような有機溶剤、好ましくはN, N'ージメチ ルホルムアミドをイオウ又はリンのオキシ酸と併用して もよい。次いで、得られたジヒドロキシビスマレイミド ジエステルの溶液を氷水または冷水中に徐々に滴下して アセチル基を加水分解することによって前記一般式

(1) 又は(2) で示される目的のピスマレイミド化合物が沈殿物として生成し、この後所望により沈殿物を濾

過、洗浄、乾燥させて純度の高い本発明のビスマレイミ ド化合物を得る。

【0016】なお以上は、前記一般式(7)又は(8)で示されるピスマレアミド酸を脱水環化させる際に、脱水剤として無水酢酸を用いる場合について説明したが、本発明のピスマレイミド化合物の合成法はこれに限定されず、例えば前記ピスマレアミド酸を触媒であるpートルエンスルホン酸及びクロロベンゼン又はキシレンの存在下で50~120℃に加熱して、加熱脱水によりピスマレアミド酸をイミド化せしめて本発明のピスマレイミド化合物を得ることもできる。

【0017】次に、本発明の感光性樹脂組成物は、上述したようなピスマレイミド化合物と、前記一般式 (3)で示される反復単位を有するポリイミド並びに前記一般式 (4)で示される反復単位を有するポリアミド酸及びその誘導体の少なくとも1種と、感光剤とを配合することにより調製される。本発明において用いられるポリイミド及びポリアミド酸は、それぞれ前記一般式 (3)及び (4)で示される反復単位を有するものであれば特に限定されず、テトラカルボン酸二無水物とジアミンを反応させることにより前記ポリアミド酸が、またこのポリアミド酸を環化させることにより前記ポリイミドが容易に合成される。

【0018】このとき用いることができるテトラカルボ ン酸二無水物としては、特に限定されないが、例えばピ ロメリット酸二無水物、3,31,4,41-ベンゾフ ェノンテトラカルボン酸二無水物、1,4,5,8-ナ フタレンテトラカルポン酸二無水物、2,3,6,7-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6 ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、3,3¹, 4, 4′-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′, 3, 3′-ビフェニルテトラカルポン酸二無水 物、2,3,31,4-ピフェニルテトラカルポン酸二 無水物、2, 3, 3, 4, -ベンゾフェノンテトラカ ルボン酸二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキ シフェニル)プロパン二無水物、2,2-ビス〔5-(3, 4-ジカルボキシフェノキシ) フェニル) プロパ ン二無水物、2,2-ビス〔4-(3,4-ジカルボキ シフェノキシ)フェニル〕プロパン二無水物、ピス (3, 4-ジカルボキシフェニル)スルホン二無水物、 ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)エーテル二無水 物、ピス(3,4ージカルボキシフェニル)メタン二無 水物、ペリレン-3,4,9,10-テトラカルポン酸二 無水物、プタンテトラカルボン酸二無水物、2,2-ビ ス(3,4-ジカルボキシフェニル)へキサフロロプロ パン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル) ジメチルシラン二無水物、1,4-ビス(3,4-ジカ ルポキシフェニルジメチルシリル)ベンゼン二無水物、 1, 3-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)-1, 1,3,3-テトラメチルジシロキサン二無水物等が挙 げられる。これらは1種又は2種以上を混合して用いる ことができる。

【0019】また、ジアミンとしては特に限定されない が、芳香族ジアミンを用いることが好ましく、例えば、 m-フェニレンジアミン、p-フェニレンジアミン、 2, 4-トリレンジアミン、4, 4'ージアミノジフェ ニルエーテル、4,4'-ジアミノジフェニルメタン、 4, 4'-ジアミノジフェニルスルホン、4, 4'-ジ アミノジフェニルスルフィド、2,2-ビス(4-アミ ノフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-アミノフェ ニル) ヘキサフロロプロパン、3,4′ージアミノジフ ェニルエーテル、3,3'-ジアミノジフェニルエーテ ル、3, 3' -ジアミノジフェニルケトン、4, 4' -ジアミノジフェニルケトン、4,4'ージアミノベンズ アニリド、ピス(4-アミノフェニル)ジメチルシラ ン、1, 3-ビス(4-アミノフェニル)-1, 1,3, 3-テトラジメチルシロキサン、1, 3-ビス(3 ーアミノフェノキシ) ベンゼン、1,3-ビス(4-ア ミノフェノキシ) ベンゼン、1,4-ピス(3-アミノ フェノキシ) ベンゼン、4-メチル-2, 4-ビス(4 -アミノフェニル)-1-ペンテン、4-メチル-2, $4 - \forall \lambda (4 - \gamma \leq 1) = 1 - (4 - \gamma \leq 1) = 1$ 4-ピス $(\alpha, \alpha-$ ジメチル-4-アミノベンジル) ベ ンゼン、イミノージーp-フェニレンジアミン、1,5 ージアミノナフタレン、2,6-ジアミノナフタレン、 4-メチル-2, 4-ビス(4-アミノフェニル)ペン タン、5(または6)-アミノ-1-(4-アミノフェ ニル) -1, 3, 3-トリメチルインダン、ピス(4-アミノフェニル) ホスフィンオキシド、4,4′-ジア ミノアゾベンゼン、4,4′ージアミノジフェニル尿 素、4,4'-ピス(4-アミノフェノキシ)ピフェニ ル、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェ ニル〕プロパン、2,2-ビス〔4-(3-アミノフェ ノキシ)フェニル)プロパン、4,4′-ビス(4-ア ミノフェノキシ) ベンゾフェノン、4,4'-ビス(3 **-アミノフェノキシ)ジフェニルスルホン、4,4´-**ピス (4-アミノフェノキシ) ジフェニルスルホン、 ベンジル)フェノキシ」ベンゾフェノン、4,4′ービ ス〔 $4-(\alpha, \alpha-i)$ メチルー $4-\gamma$ ミノベンジル)フ ェノキシ〕ジフェニルスルホン、2,2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル) ヘキサフロロプロ パン等の芳香族ジアミンが挙げられる。なお、これらの 芳香族ジアミンの芳香核の水素原子が、塩素原子、フッ 素原子、臭素原子、メチル基、メトキシ基、シアノ基、 フェニル基等の群より選択される少なくとも1種の置換 基により置換された化合物であってもよい。さらには、 上述した芳香族ジアミンの他にも、例えば、ジメチレン ジアミン、トリメチレンジアミン、テトラメチレンジア ミン、ヘキサメチレンジアミン、ヘプタメチレンジアミ

ン、オクタメチレンジアミン、ノナメチレンジアミン、 デカメチレンジアミン、1, 2-ピス ($3^{\prime}-$ アミノプロポキシ) エタン、

【0020】 【化7】

 $H_2N = (CH_2)_3 = O = (CH_2)_2 = O = (CH_2)_3 = NH_2$

【0022】また、本発明において用いられるポリアミド酸誘導体としては、例えば、上記したようなポリアミド酸のエステル等が挙げられる。このようなポリアミド酸のエステルの合成法としては、上記したようなテトラカルボン酸二無水物とアルコール、フェノール、アルコキシド等を反応せしめテトラカルボン酸のエステルを生成させた後、上記したようなジアミンと反応せしめる方法等が採用され得る。

【0023】さらに本発明では、感光性樹脂組成物のア ルカリ可溶性及び溶媒可溶性を高める観点から、前記一 般式(3)で示される反復単位を有するポリイミドにお いて、この反復単位中における有機基R2 がフェノール 性水酸基を有していることが好ましい。このようなポリ イミドは、まず上述したようなテトラカルボン酸二無水 物とフェノール性水酸基を有するジアミンとを反応させ ポリアミド酸を生成させた後、このポリアミド酸を環化 させることにより合成することができる。ここで前記フ エノール性水酸基を有するジアミンとしては、例えば、 3, 5-ジアミノー1-ヒドロキシベンゼン、3, 3' -ジヒドロキシー4, 4'-ジアミノビフェニル、4, 4'ージヒドロキシー3,3'ージアミノピフェニル、 2, 2-ビス(4-アミノ-3-ヒドロキシフェニル) プロパン、2,2-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシ フェニル)プロパン、ビス(3-アミノ-4-ヒドロキ シフェニル) スルフィド、ビス (3-アミノ-4-ヒド ロキシフェニル)スルホン、ピス(3-アミノー4-ヒ ドロキシフェニル) メタン、ビス (4-アミノ-3-ヒ ドロキシフェニル) メタン、2, 2-ピス (4-アミノ -3-ヒドロキシフェニル) ヘキサフロロプロパン、 2, 2-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフロロプロパン等が挙げられる。これらは1種又 は2種以上を混合して用いることができる。

【0024】なおこのとき、このようなフェノール性水 酸基を有するジアミンと前述したようなフェノ―ル性水 酸基を有していないジアミンとを併用して、上記ポリイ ミドを合成することも可能である。この場合、ポリイミ ドの合成に用いられるフェノール性水酸基を有するジア ミンの量は、全ジアミン中50モル%以上、さらには60モ ル%以上とすることが望ましい。この理由は、フェノー ル性水酸基を有するジアミンの量が少なすぎると、得ら れるポリイミドを配合することにより調製される本発明 の感光性樹脂組成物において、アルカリ可溶性及び溶媒 可溶性を効果的に高めることが困難となるからである。 本発明では、上述したようにポリイミドの合成に当っ て、フェノ―ル性水酸基を有するジアミンとフェノ―ル 性水酸基を有していないジアミンとを併用することによ り、最終的には骨格中にフェノール性水酸基を有する反 復単位とフェノ―ル性水酸基を有していない反復単位を 含む共重合体構造のポリイミドが配合された感光性樹脂 組成物が調製され得る。

【0025】本発明において、前記一般式(3)で示さ れる反復単位を有するポリイミドの前駆体であるポリア ミド酸並びに前記一般式 (4) で示される反復単位を有 するポリアミド酸及びその誘導体の合成は、通常有機溶 媒中で前記テトラカルボン酸二無水物(又はテトラカル ボン酸エステル)とジアミンとを重縮合させることによ り行なわれる。このとき用いられる有機溶剤としては、 例えば、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメ チルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン、N-メチルー ε ーカプロラクタム、γ ープチロラクトン、ス ルホラン、N, N-ジメチルスルホキシド、N, N, N´, N´ーテトラメチル尿素、テトラヒドロフラン、 メチルセロソルプアセテート、ジクライム、シクロヘキ サノン等が挙げられる。またこのようなポリアミド酸の 合成において、テトラカルボン酸二無水物とジアミンと の好ましい配合割合は、モル比で 0.9~ 1.1:1であ り、両成分が等モル配合されることがより好ましい。さ らに反応条件としては、反応温度-10~ 100℃、反応時 間 0.5~24時間の範囲である。

【0026】こうして合成されるポリアミド酸の分子量については、本発明では特に限定されないが、基体に塗布した際に充分な物理的強度を有する膜が得られる程度に高分子量化されていることが好ましい。従ってこの観点から、ポリアミド酸の対数粘度(N-メチル-2-ピロリドン溶媒中において、ポリマー濃度 0.5g/d1、30℃で測定)が 0.10 d1/g以上であることが好ましい。【0027】以上のような条件で合成されたポリアミド酸は、溶液のまま用いてもよいし、またポリアミド酸溶

液を水、メタノ―ル、エタノ―ル、イソプロピルアルコール、アセトン等の貧溶剤に注入してポリマ―を析出させ、洗浄、乾燥して固体として回収した後使用してもよい。

【0028】本発明に係る前記一般式(3)で示される 反復単位を有するポリイミドは、前駆体のポリアミド酸 を環化させることにより得られるが、この環化は加熱処 理又は化学処理によって行なわれる。加熱処理による方 法では、ポリアミド酸溶液をトルエン、キシレン、クロ ロベンゼン等水と共沸混合物を形成する有機溶剤の存在 下、イミド化により副生する水を共沸留去することによ り環化反応が起こりポリイミドが生成される。また化学 処理による方法では、ポリアミド酸溶液を無水酢酸、ポ リリン酸、トリフェニルホスフィン、亜リン酸トリフェ ニル、ジシクロヘキシルカルボジイミド、トリエチルア ミン、ピリジン、塩化コリン、酢酸ナトリウム、酢酸マ ンガン、酢酸コバルト等の存在下、-20~ 150℃の温度 範囲で1分~24時間反応させることにより環化反応が起 こりポリイミドが生成される。以上のような条件で合成 されたポリイミドは、溶液のまま用いてもよいし、また ポリイミド溶液を水、メタノ―ル、エタノ―ル、イソプ ロピルアルコール、アセトン等の貧溶剤に注入してポリ マーを析出させ、洗浄、乾燥して固体として回収した 後、使用してもよい。

【0029】本発明の感光性樹脂組成物において、前記一般式(3)で示される反復単位を有するポリイミド及び前記一般式(4)で示される反復単位を有するポリアミド酸又はその誘導体が併用される場合、その配合割合は前記ポリイミドの配合量がこれらの合計量中20~99.9 重量%に設定されることが好ましい。この理由は、ポリイミドの配合量が20重量%未満であるとパターン形成時に露光部、未露光部共に現像液に対する溶解速度が速く

なって、解像度の優れたパタ―ンを形成することが困難となるおそれがある。逆にポリイミドの配合割合が99.9 重量%を超えると、ポリアミド酸の配合によるポリイミド膜の機械的強度の向上の効果が得られなくなるからである。さらに、ポリイミドの配合割合が30~90重量%であることがより好ましい。

【0030】さらに本発明の感光性樹脂組成物では、前記一般式(1)及び(2)のいずれかにて示されるピスマレイミド化合物の配合量は、前記一般式(3)で示される反復単位を有するポリイミド並びに前記一般式

(4)で示される反復単位を有するポリアミド酸及びその誘導体の合計量に対し、0.1~50重量%とすることが好ましい。この理由は、ビスマレイミド化合物の配合量が少なすぎると、得られる感光性樹脂組成物の感光特性が不充分でかつパターン形成後のポリイミド膜パターンと基体との良好な密着性が得られず、逆にビスマレイミド化合物の配合量が多すぎると、前記ポリイミド膜パターンが脆くなりやはり基体との充分な密着性が得られない傾向があるからである。さらに、ビスマレイミド化合物の配合割合が5~30重量%であることがより好ましい。

【0031】本発明において用いられる感光剤としては、分子中にo-キノンジアジド基を少なくとも1個有するo-キノンジアジド化合物又は分子中にナフトキノンジアジド基を少なくとも1個有するナフトキノンジアジド化合物のようなジアジド化合物が挙げられる。具体的には、以下の構造式で示される化合物(QD-1)~(QD-16)からなる群より選ばれた少なくとも1種の化合物等が使用され得る。

[0032]

【化8】

[0033]

$$CH_3$$
 CH_3 CH_4 CH_5 CH_5 CH_5 CH_6 CH_7 CH_8 CH_8

を表す。)

【0035】 これらの化合物のなかでも、前記(QD-1)及び(QD-2)のような2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノンの1, 2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル類や、前記(QD-4)及び(QD-

5) のような 2, 3, 4, 4 ' - テトラヒドロキシベン プフェノンの 1, 2 - ナフトキノンジアジドスルホン酸 エステル類、前記(QD-7)及び前記(QD-10)のような 2 - (4 - アミノフェニル)-2 - (4 - ヒドロ

キシフェニル)プロパンの1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル類等は、本発明において特に好ましい感光剤である。

【0036】例えば、(QD-4)で示される2,3, 4, 4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン-1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステルは、g 線露光用感光剤として好適であり、また(QD-5)で 示される2, 3, 4, 4′-テトラヒドロキシベンゾフ ェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン 酸エステルは前者よりも短波長の紫外線露光用感光剤と して好適である。尚、この2, 3, 4, 4′ーテトラヒ ドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジ ド-4-スルホン酸エステルにおいて、1,2-ナフト キノンジアジドスルホン酸による2,3,4,4′-テ トラヒドロキシベンゾフェノンのエステル化率は、通常 前記ベンゾフェノン化合物における水酸基総数の40~1 00%となっている。換言すれば、2,3,4,4′-テ トラヒドロキシベンゾフェノン1分子(水酸基数4)当 たりの平均的ナフトキノンジアジドの導入数は 1.6~4 個であり、この感光剤は、前記ナフトキノンジアジドの 導入数が1、2、3、又は4のスルホン酸エステルの混 合物ということになる。

【0037】本発明において、前記感光剤の配合量は感光性樹脂組成物中1~50重量%であることが好ましい。この理由は、感光剤の配合量が少なすぎると感光性樹脂組成物の感度が不充分となり、感光剤の配合量が多すぎるとパターン形成後の感光剤の残渣のため、得られるポリイミド膜の特性が低下するおそれがあるからである。さらに、より好ましい感光剤の配合量は5~30重量%である。

【0038】また本発明の感光性樹脂組成物では、必要に応じて増感剤、染料、界面活性剤、アルカリ可溶性樹脂等を添加配合することもできる。尚、ここでアルカリ可溶性樹脂としては特に限定されないが、例えば、ポリーpービニルフェノール、ポリーのービニルフェノール、ポリーmーイソプロペニルフェノール、m, pークレゾールノボラック樹脂、キシレゾールノボラック樹脂、pービニルフェノール及びメタクリル酸メチルの共重合体、pーイソプロペニルフェノール及び無水マレイン酸の共重合体、ポリメタクリル酸、以下の各反復単位を含む各ポリマー;

[0039]

【化11】

等のアルカリ可溶性樹脂が使用され得る。次に、本発明の感光性樹脂組成物を用いたパターン形成方法について 詳細に説明する。

【0040】まず、前記ポリイミド並びにポリアミド酸及びその誘導体の少なくとも1種と本発明のビスマレイミド化合物と例えば感光剤のジアジド化合物とを所定の濃度となるように適当な有機溶剤に溶解し、所望により濾過等の方法で微細な不純物を除去してワニスを調製する。次いで、前記ワニスを例えば回転塗布法により半導体基板等の基体上に塗布した後、これを乾燥して本発明に係る樹脂層を形成する。尚、このときの有機溶剤としては、前述したようなポリアミド酸の合成の際に用いられるものと同様の有機溶剤が用いられる。ここで本発明の感光性樹脂組成物では、溶剤溶解性が優れているため塗膜性が改善されており、厚膜の形成に良好に作用す

る。

【0041】次に、前記樹脂層を60~100℃でプレキュアした後、所望のパターンを有するフォトマスクを介して樹脂層に可視光、赤外光、紫外光、EB、X線等のエネルギー線を照射し、前記樹脂層の所望領域を露光する。なおこのとき、密着、投影のいずれの露光方式も可能である。

【0042】このとき露光部分では、感光剤のジアジド化合物におけるoーキノンジアジド基又はナフトキノンジアジド基が、光化学反応及び系中の水分によって、ケトンを経てカルボン酸に変化する。以下に、感光剤として1,2ーナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステルを用いた場合について、上記反応の進行を示す。

[0043]

【化12】

【0044】続いて、前述したような露光を行なった後 の樹脂層に対して、アルカリ水溶液を使用した浸漬法、 スプレー法等により現像処理を行なう。このアルカリ水 溶液には、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム等の無機 アルカリ水溶液、又はプロピルアミン、ブチルアミン、 モノエタノールアミン、エチレンジアミン、トリメチレ ンジアミン、トリメチルアンモニウムヒドロキシド、ヒ ドラジン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、ト リメチル-2-ヒドロキシエチルアンモニウムヒドロキ シド等からなる群より選ばれる少なくとも1種の有機ア ルカリ水溶液等が使用され得る。また前記したようなア ミン化合物に、メタノール、エタノール、2-プロパノ 一ル、エチレングリコール、セロソルブ、メチルセロソ ルブ、ブチルセロソルブ、ジエチレングリコール、エチ ルカルビト―ル、水等の本発明の感光性樹脂組成物の貧 溶媒、又はN-メチルピロリドン、N, N-ジメチルホ ルムアミド、N. N-ジメチルアセトアミド、ジメチル スルホキシド等の本発明の感光性樹脂組成物の溶媒を混 合したものも使用され得る。

【0045】このとき、樹脂層の未露光部分では、ジアジド化合物がアルカリ水溶液に対する溶解性抑止剤として働き、樹脂成分単独のときよりも現像液に溶けにくくなっている。一方露光部分では、上述した光反応により、ジアジド化合物が前記カルボン酸に変化している。このカルボン酸のカルボキシル基がアルカリ水溶液中のアルカリ金属イオン又はアンモニウムイオン等と反応して塩を形成し、露光部分が現像液に溶解する。従って前記樹脂層では、このような現像処理によって未露光部分のみが残存する。すなわち本発明の感光性樹脂組成物は、その露光部分が現像液に対して可溶化するポジ型フォトレジストとしての機能を奏する。

【0046】尚、例えば前記一般式(3)で示される反復単位を有するポリイミドと感光剤としてのジアジド化合物のみを配合してなる従来の感光性樹脂組成物においては露光部分での光反応により生じる前記カルボン酸の作用だけでは、アルカリ現像液に対する溶解性が不充分

な場合がある。これは、前記ポリイミドがテトラカルボン酸二無水物とフェノール性水酸基を有していないジアミンとから合成されたものであるとき、特に顕著である。これに対し本発明の感光性樹脂組成物では、前記ビスマレイミド化合物を配合することにより、このビスマレイミド化合物におけるフェノール性水酸基が前記カルボン酸のカルボキシル基と同様の作用を有している。従ってビスマレイミド化合物のフェノール性水酸基も現像時同様にアルカリ塩を形成し、露光部分における樹脂層のアルカリ現像液に対する溶解性を助長することができる。

【0047】また本発明では、前述したような現像工程の後、現像液残渣等を除去する目的で、水、アルコール、アセトン、酢酸エステル類等によるリンス処理を行なってもよい。

【0048】次いで、前記の現像処理により所定のパターンが得られた樹脂層を所定温度で加熱する。これにより、樹脂層中の感光剤が除かれ、ポリアミド酸が含有されている場合このポリアミド酸の環化反応が起こり、ポリイミド膜が生成される。尚このときの加熱工程では、90℃から 400℃まで徐々に昇温することが好ましい。これは、急激な昇温を行なうとポリイミド膜生成時にポリアミド酸の環化反応以外の好ましくない反応が生じるおそれがあるからである。

【0049】上述したような工程により得られるポリイミド膜パターンは、優れた電気絶縁性及び耐熱性を示し、しかも前述したように本発明のピスマレイミド化合物を用いたため、充分な基体との密着性を有していることから、半導体装置におけるパッシベーション膜又は層間絶縁膜として好適に機能する。またPEP(Photo Engraving Process)におけるエッチングマスクとして用いることもできる。

【0050】尚以上は、本発明のビスマレイミド化合物を用いた感光性樹脂組成物について詳述したが、本発明のビスマレイミド化合物の用途はこれに限定されず、例えばエポキシ樹脂と配合して積層板に供することもでき

る。このような本発明のビスマレイミド化合物を用いた 積層板では、ビスマレイミド化合物がフェノール性水酸 基を有していることに起因し前記エポキシ樹脂との反応 性を備えているため、エポキシ樹脂とビスマレイミド化 合物との架橋反応が生じ、結果としてフェノール性水酸 基を有してないビスマレイミド化合物を用いたときより も優れた耐熱性を得ることが可能となる。

[0051]

【実施例】以下に、本発明を実施例により詳細に説明する。

(1) ピスマレイミド化合物の合成

合成例1

【0052】反応フラスコ中に、ジアミノ化合物として 2,2 ービス(3 ーアミノー4 ーヒドロキシフェニル) ヘキサフロロプロパン36.6g (0.10 モル)及びアセトン 100gを投入し、充分に撹拌して均一溶液とした。この溶液に無水マレイン酸20.6g (0.21 モル)を徐々に添加し、室温で3時間撹拌を続けビスマレアミド酸を生成した。次に酢酸コバルト 2.5g (0.01 モル),無水酢酸47g (0.46 モル)及びトリエチルアミン 2.0g

(0.02 モル)を添加して昇温し、アセトンの還流温度

$$\begin{array}{c|c}
O & O & O \\
\parallel & C & \parallel & O \\
C & N & C & \parallel & C \\
C & N & C & N & C \\
\parallel & HO & C & F_3 & C \\
\downarrow & C & N & C & O \\
\parallel & & & & & & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & \\
C & N & & & & & & & \\
C & N & & & & & & \\
C & N & & & & & & \\
C & N & & & & & & \\
C & N & & & & & & \\
C & N & & & & & & \\
C & N & & & & & & \\
C & N & & & & & & \\
C & N & & & & & & \\
C & N & & & & & & \\
C & N & & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & & & & \\
C & N & & &$$

合成例2

【0055】反応フラスコ中に、ジアミノ化合物として3,3′ージヒドロキシー4,4′ージアミノビフェニル21.6g(0.10 モル)及びアセトン 100gを投入し、充分に撹拌して均一溶液とした。この溶液に無水マレイン酸21.6g(0.22 モル)を徐々に添加し、室温で5時間撹拌を続けビスマレアミド酸を生成した。次に酢酸コバルト 2.5g(0.01 モル),無水酢酸47g(0.46 モル)及びトリエチルアミン 2.0g(0.02 モル)を添加して昇温し、アセトンの還流温度で撹拌を3時間続けた後アセトン50gを留去して室温で冷却した。次いで、この反応液にメタノール 100gを加えて沈殿物を生成せしめ、濾過,水洗,乾燥してジヒドロキシビスマレイミドジエステルを得た。

【0056】続いて前記ジヒドロキシマレイミドジエス

(2) 感光性樹脂組成物の調製及びポリイミド膜パターンの形成

実施例1

で撹拌を2時間続けた後室温で冷却した。次いで、この 反応液を水中に投入することにより沈殿物を生成せし め、濾過、水洗、乾燥して粉末状のジヒドロキシピスマ レイミドジエステル62.1gを得た(収率96%)。

【0053】続いて前記ジヒドロキシマレイミドジエステル20gを、50℃の温度条件で硫酸30gとN、Nージメチルホルムアミド20gとの混合溶液に溶解させて溶液を調製し、この溶液を11の氷水中に徐々に滴下することにより沈殿物を生成せしめ、この後濾過、水洗、乾燥して粉末状のビスマレイミド化合物を得た(収率67%)。図1に、得られたビスマレイミド化合物の赤外線吸収スペクトル図を示す。このビスマレイミド化合物は、以下に示す通り元素分析による各元素の分析値が計算値と良く一致していることから、下記化学式で示されるビスマレイミド化合物(BM-1)であることが確認された。

 C
 H
 N

 計算値
 52.48 %
 2.30 %
 5.32 %

 分析値
 52.57 %
 2.23 %
 5.41 %

 [0 0 5 4]
 [化1 3]

テル20gを、50℃の温度条件で硫酸40gとN, N-9メ チルアセトアミド30gとの混合溶液に溶解させて溶液を調製し、この溶液を11の氷水中に徐々に滴下することにより沈殿物を生成せしめ、この後濾過,水洗,乾燥して粉末状のビスマレイミド化合物を得た(収率73%)。このビスマレイミド化合物は、以下に示す通り元素分析による各元素の分析値が計算値と良く一致していることから、下記化学式で示されるビスマレイミド化合物(BN-2)であることが確認された。

 C
 H
 N

 計算值
 63.8%
 3.2%
 7.4%

 分析值
 63.2%
 3.5%
 7.0%

 【0 0 5 7】
 【化 1 4】

【0058】撹拌棒、温度計、滴下ロートを取り付けた 反応フラスコ中に、五酸化リンによって乾燥した窒素ガスを通し、3,3′,4,4′-ペンゾフェノンテトラ

(BM-2)

カルボン酸二無水物16.11g(0.05 モル)及びN、Nージメチルアセトアミド50gを注入した。そして、これらを充分に撹拌、混合して0℃まで冷却した。次に、2、2ーピス(3-アミノー4-ヒドロキシフェニル)へキサフロロプロパン18.31g(0.05 モル)をN、Nージメチルアセトアミド50gに溶解させ、この溶液を0℃で保持した前記反応フラスコ中に徐々に滴下した。こうして得られた混合液を、0~10℃にて6時間撹拌して、ポリアミド酸を合成した。尚、このポリアミド酸の濃度0.5g/d10N-メチル-2-ピロリドン溶液について、30℃での対数粘度を測定したところ、0.51 d1/gであった。

【0059】次に、無水酢酸11.2g(0.11 モル)及び ピリジン 0.2g(0.0025 モル)をN, Nージメチルア セトアミド10gに溶解させ、この溶液を前記ポリアミド酸/Nーメチルー2ーピロリドン溶液に加えて、室温で18時間撹拌しポリアミド酸を環化させた。さらに、こうして得られた溶液を50容量%メタノール水溶液中に注入してポリイミドを析出させ、これを洗浄、乾燥して生成したポリイミドを固体として取得した。

【0060】続いて、同様の反応フラスコ中に3、3′、4、4′ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物12.09g(0.0375 モル)、ピロメリット酸二無水物2.73g(0.0125 モル)及びNーメチルー2ーピロリドン60gを注入した。そしてこれらを充分に撹拌、混合して10℃まで冷却した。次いで、4、4′ージアミノジフェニルエーテル9.41g(0.047モル)及び1、3ービス(γ -アミノプロピル)ー1、1、3、3ーテトラメチルジシロキサン0.75g(0.003モル)をNーメチルー2ーピロリドン40gに溶解させ、この溶液を10℃で保持した前記反応フラスコ中に徐々に滴下した。こうして得られた混合液を10~15℃にて6時間撹拌して、ポリアミド酸を合成した。このポリアミド酸/Nーメチルー2ーピロリドン混合液について、30℃において対数粘度を測定したところ、1.2d1/gであった。

【0061】次に、前記ポリイミド3g、前記(QD-4)の感光剤(平均エステル置換類3) 0.7g及び前記合成例1で得た(BM-1)のピスマレイミド化合物 1.0gをN-メチル-2-ピロリドン9gに溶解し、さらにこの溶液に前記ポリアミド酸/N-メチル-2-ピロリドン混合液3gを添加し、充分撹拌して均一な溶液とした後、細孔寸法 <math>0.5μmoメンプランフィルターで濾過することによって本発明の感光性樹脂組成物のワニスを調製した。

【0062】このワニスを、径5インチのシリコンウェハー上にスピンナーを用いて塗布し、これを90℃のホットプレート上で20分間乾燥して、厚さ 5.1 μ mの樹脂層を形成した。この後露光機(キャノン社製: PLA 501 F)により前記樹脂層の表面を所定のマスクを介して紫外線(11.0 mW/cm², 405nm)で30秒間照射した(照

射量 330 mJ/cm²)。露光後、シリコンウェハ―を濃度2重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間現像したところ、未露光部をほとんど侵蝕することなく、線幅4μmの微細かつ鮮明なレリーフパターンが得られた。さらに、得られたレリーフパターンに、90℃で30分間,150℃で30分間,250℃で30分間,320℃で30分間の熱処理を施し、樹脂層中のポリアミド酸をポリイミドに環化させた後も前記レリーフパターンが損なわれることがなく、4μmの幅の解像度が達成されていることが確認された。

【0063】また、同じ感光性樹脂組成物のワニスを、径3インチのシリコンウェハー上にスピンナーを用いて塗布し、これを90℃のホットプレート上で20分間乾燥して、厚さ5μmの樹脂層を形成した。この後、この樹脂層に 150℃で30分間, 250℃で30分間, 320℃で30分間の熱処理を施し、樹脂層中のポリアミド酸を環化させてポリイミド膜を形成した。

【0064】次いで、得られたポリイミド膜にナイフにより2mm角の大きさのゴバン目状の切り込みを入れ、粘着性セロハンテープを用いた剥離試験を行なったところ、ポリイミド膜はシリコンウェハーから全く剥れなかった。また、このポリイミド膜を 120℃、2気圧の飽和水蒸気雰囲気に 100時間さらした後、同様の試験を行なってもポリイミド膜の剥れは全く認められず、本発明の感光性樹脂組成物によればシリコンウェハーとの優れた密着性を有するポリイミド膜を形成できることが確認された。

実施例2~7

【0065】表1及び表2に示す原料組成で前記実施例 1と同様の方法により、実施例2~7に使用するポリイミド及びポリアミド酸を合成した(表1及び表2中には、係る樹脂成分の合成時に得られたポリアミド酸/N-メチルー2-ピロリドン溶液の対数粘度を併記した)。尚、実施例6では、ポリイミドの合成に当たって有機溶剤としてはN-メチルー2-ピロリドンを単独で使用し、また触媒としてピリジン 0.2gの代わりにトリエチルアミン 0.25gを使用してポリアミド酸を環化させた。

【0066】以下実施例1と同様に、前記ポリイミド及びポリアミド酸溶液(20重量%N-メチル-2-ピロリドン溶液)の少なくとも1種に前記(BM-1)又は(BM-2)のビスマレイミド化合物、前記(QD-4)又は(QD-9)の感光剤及びN-メチル-2-ピロリドンがそれぞれ表1及び表2に示した所定量配合されてなる実施例2~7の感光性樹脂組成物のワニスを調製した。尚、表1及び表2中で用いる略号は、それぞれ以下に示すテトラカルボン酸二無水物及びジアミンを表す。

テトラカルボン酸二無水物 PMDA:ピロメリット酸二無水物 BTDA: 3, 3', 4, 4'-ベンゾフェノンテトラ カルボン酸二無水物

6 F D A: 2, 2 - (3, 4 - ジカルボキシフェニル) ヘキサフロロプロパン二無水物

STDA: 3, 3['], 4, 4['] - ジフェニルスルホンテトラカルポン酸二無水物ジアミン

6 FAP: 2, 2 - ピス (3 - アミノ - 4 - ヒドロキシフェニル) ヘキサフロロプロパン

HAB : 3, 3'ージヒドロキシー4, 4'ージアミ ノビフェニル ODA : 4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル BAPP: 2, 2-ビス [4-(4-アミノフェノキ

シ) フェニル] プロパン

HFBAPP: 2, 2ーピス [4-(4-アミノフェノ キシ) フーニル | ヘナサフロロプロパン

キシ)フェニル] ヘキサフロロプロパン

TSL : 1, 3-ピス $(\gamma-$ アミノプロピル)-1,

1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン 【0067】

【表1】

1 2 3 4 5 6	5 5.45 2.73 5.45	- 0.025 0.025 0.0125 0.025 -	16.11 8.06 8.06 12.08 8.06 —	0.05 0.025 0.025 0.0375 0.025 —	17.9		18.31 18.31 — 18.31 18.31 —	0.05 0.05 — 0.05 0.05 —		- 0.05	19.3	0.047	0.74	0.003	0.51 0.49 0.72 0.54 0.49 0.48	S S S S
	(8)	「いいろ (モル)	(g)	υΩ (モル)	(g)	(₹ <i>I</i> ν)	(g)	(モル)	(\$)	(±1v)	(\$) ddv8	(モル)	(%)	(モル)		
		テトラカルボン	酸二無水物 (9)	T a	£ o		tr w		ジアミン (4)		4 8			•	対数粘度 (d1/g)	配合量 (4)

						张	摇	160		
				1	2	8	4	2	9	7
	1	PMDA	(g)	2.73	2.73	1	2.73	2.73	1	2.73
-	トトルセラボン		(モル)	0.0125	0.0125	1	0,0125	0.0125	ı	0,0125
ĸ	展二無芥物 (9)	BTDA	(de)	12,09	12,09	8.06	12,09	12.09	1	12.09
			(F)	0.0375	0.0375	0.025	0.0375	0.0375	1	0.0375
<u>-</u>		6 F D A	(8)	1	_	11,11		1		
			(モル)		1	0.025	1	1	1	1
<u>~</u>		ODA	(8)	9.41	6.01	6.01	9.41	6.01		9.41
,			(# (\(\frac{\pi}{2}\))	0.047	0.03	0.03	0.047	0.03	1	0.047
•••	シャルン(や)	ВАРР	6	1	-	6.98	I	1	!	1
:			(モル)	ı	1	0.017		ļ	1	
'Z		HFBAPP	(8)		8.20	1		8.20	1	I
í			(H)	1	0.017	1	-	0.017		1
2		TST	&	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75		0.75
			(₩)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	1	0.003
	対数格度 (d1/g)	(g)		1.2	1.5	1.2	1.2	1.5		1.2
	20重量%N-メチル-2-ピロリドソ裕敬 配合量(9)	2 - ピロリドン 9)	凝	က	8	ы	₆	က	1	20
スス	アスマワイミド化合物配合量(4)		(BM-1)	1.0	1.0	1.0	0.1	1.0		2.0
			BM-2)	I	1	ŀ			1.5	
色色	光剂配合量(4)	G	(QD-4)	0.70	0.70	0.70	_	ı	0.70	1.0
		(QD-	(6)	1	1	1	0.70	0.70		1
Z	Nーメチルー2~ピロリドン配合量 (g)	(配合量(多)		б	-	П		1	12	2

【0069】これらのワニスについて、実施例1と同様の方法でシリコンウェハー上において成膜、露光、現像、熱処理を行ない、ポリイミド膜パターンを形成した。このときの成膜時の初期膜厚、露光時の光照射量、現像時の現像液濃度、現像時間、得られたパターンの解像度を表3に示す。表3から明らかなように、実施例2~7においても高い解像度でポリイミド膜パターンが形成された。

【0070】さらに実施例 $2\sim7$ の感光性樹脂組成物について、実施例1と同様にシリコンウェハー上にポリイ

ミド膜を成膜し剥離試験を行なったところ、いずれもシリコンウェハ―からポリイミド膜の剥れは全く認められなかった。次いで、ポリイミド膜を実施例1と同様飽和水蒸気中にさらした後同様の試験を行なったところ、やはりポリイミド膜の剥れは全くなく、これらの感光性樹脂組成物においても、シリコンウェハ―との密着性の高いポリイミドを形成できることが確認された。

[0071]

【表3】

			実	施	<i>9</i> 3		
	1	2	3	4	5	6	7
初期膜厚 (un)	5.1	5.3	5.1	4.8	5.3	8.0	4.0
光照射量(s.J/od)	330	250	200	200	200	440	300
解健度(200)	4	4	5	4	4	6	5
現像被適度(重量%)	2.0	2.0	2.0	2,0	2.0	4.0	2.0
現像時間(秒)	60	60	60	60	60	140	60

[0072]

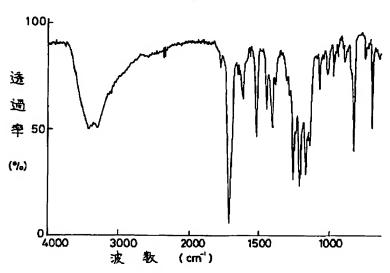
【発明の効果】以上詳述したように、本発明によればアルカリ可溶性を有するビスマレイミド化合物が提供され、さらにはこのビスマレイミド化合物を用いることによって、基体との密着性の高いポリイミド膜パタ―ンを

アルカリ現像により形成することが可能な感光性樹脂組 成物を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例で得られたピスマレイミド化合物の赤外線吸収スペクトル図である。





フロントページの続き

(51) Int.C1.⁵ G 0 3 F 7/037 識別記号 庁内整理番号 501

FΙ

技術表示箇所